

افزایش میخکوبی شار در ابررسانای MgB_2 آلاییده به سوکسینیک اسید ($C_4H_6O_4$)

قربانی، شعبان رضا؛ دارینی، مرتضی

گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار

چکیده

دو نمونه ابررسانای آلاییده به ۱۰٪ وزنی سوکسینیک اسید بدون اضافه نمودن تولوئن و با افزودن آن به روش *in-situ* ساخته شدند. اثر آلایش سوکسینیک اسید ($C_4H_6O_4$) بر روی وابستگی میدان مغناطیسی چگالی جریان بحرانی و نیروی میخکوبی MgB_2 بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن سوکسینیک اسید باعث افزایش نیروی میخکوبی در میدان های بالا و بهبود (H_c) می شود.

Improvement of flux pinning in succenic acid-doped MgB_2 Superconductor

Ghorbani, S R ; Dareini, M

Department of physics, Tarbiat Moallem University of Sabzevar, P.O.Box 397 , Sabzevar, Iran

Abstract

Two samples of $C_4H_6O_4$ -doped MgB_2 superconductor were fabricated by *in-situ* method. The samples were prepared by adding Toluene and without it. The effect of succenic acid doping on the magnetic field dependence of critical current density and flux pinning force in MgB_2 were studied. Results showed that succenic acid doping increased flux pinning force in high magnetic fields and improved the behavior of $J_c(H)$.

PACS: 74

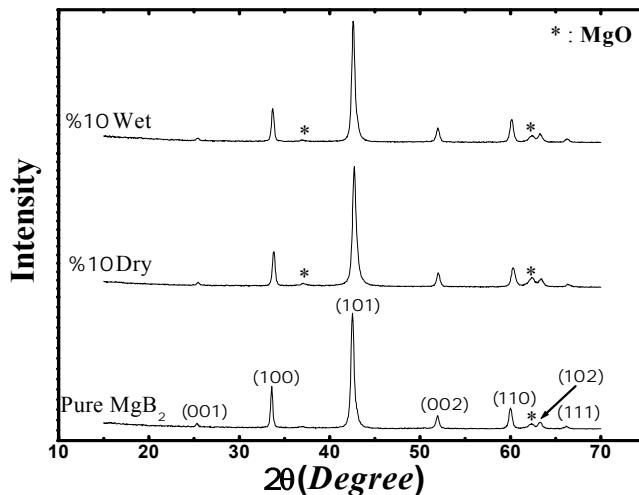
عملکرد ابررسانای MgB_2 از نانو عناصر، نانو اکسیدها، کربوهیدراتها و دیگر ترکیبات آلی استفاده شده است [۴، ۳]. نتایج به دست آمده نشان می دهند که کربن و ترکیبات کربن دار مناسب ترین مواد برای آلایش MgB_2 می باشد. با وارد شدن کربن به شبکه MgB_2 و قرار گرفتن آن در جایگاه بور میخکوبی و چگالی جریان بحرانی افزایش پیدا می کند. تحقیقات صورت گرفته روی منابع مختلف کربن مانند SiC [۶، ۵]، $C60$ [۷]، روغن سیکلون [۸] و نانو لوله های کربن [۹] افزایش J_c را نشان می دهد.

در این مقاله اثر آلایش سوکسینیک اسید ($C_4H_6O_4$) به عنوان یک منبع کربن روی چگالی جریان بحرانی (J_c) و نیروی میخکوبی (F_p) بررسی می شود. جانشینی کربن به جای بور باعث ایجاد بی نظمی در نوار سیگما می شود که میدان بحرانی بالایی و J_c را از طریق میخکوبی افزایش می دهد. علاوه بر این کربن

مقدمه :

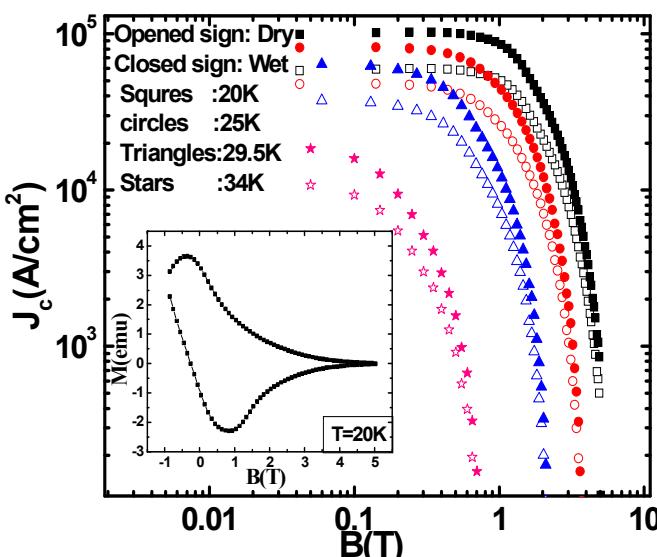
ابررسانای MgB_2 پتانسیل بالایی برای استفاده در کاربردهای توان الکتریکی و قطعات الکترونیکی دارد [۱]. دمای بحرانی بالا (۳۹ K)، طول همدوسي بزرگ (۵ nm)، مواد اولیه ارزان قیمت، ساختار شیمیایی ساده و پایدار از برتری های MgB_2 نسبت به سایر ابررساناهای دمای بالا است. دمای بحرانی بالا استفاده از MgB_2 را در هیدروژن مایع (20 K) ممکن می سازد و طول همدوسي بزرگ امکان رسیدن به چگالی جریان بحرانی از مرتبه $10^5 A/cm^2$ صرف نظر از میزان همترازی دانه ها میسر می کند [۲]. کمبود مراکز میخکوبی و ضعیف بودن اتصالات دانه ای در MgB_2 سبب می شود مقدار J_c در میدان های مغناطیسی بالا به شدت افت کند. این مشکل با وارد کردن نانوذرات و افزایش نیروی میخکوبی رفع می شود [۳، ۴]. در سال های اخیر برای بهبود

جزیی قله (۱۰۰) به سمت زوایای بالاتر به دلیل کوچکتر شدن پارامتر a و جانشینی کربن در جایگاه بور می باشد.



شکل ۱: الگوهای پراش اشعه X برای MgB_2 خالص و نمونه‌های خشک و تر آلاییده به ۱۰٪ وزنی سوکسینیک اسید.

حلقه‌های پسماند مغناطیسی در محدوده دمایی $34 - 20$ کلوین برای هر دو نمونه اندازه‌گیری و چگالی جریان بحرانی با استفاده از مدل بحرانی بین محاسبه شد. بر اساس این مدل $J_c = 20\Delta M/V[w(1-w/3l)]$ است که ΔM ارتفاع حلقة پسماند M-H، V حجم نمونه، l طول و عرض نمونه‌اند که بر میدان اعمالی عمودند. نتایج (B,T) برای هر دو نمونه خشک و تر درنمودار دوبل لگاریتمی شکل ۲ ارائه شده است. حلقه پسماند در دمای K ۲۰ برای نمونه ۱۰٪ خشک درضمیمه شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲: (B,T) بسته آمده از حلقه‌های مغناطیش برای نمونه‌های خشک و تر. ضمیمه حلقه مغناطیش در دمای K ۲۰ برای نمونه خشک می‌باشد.

اضافی که وارد شبکه نمی‌شود به عنوان ناخالصی در شبکه MgB_2 باعث میخکوبی خطوط شار می‌شود.

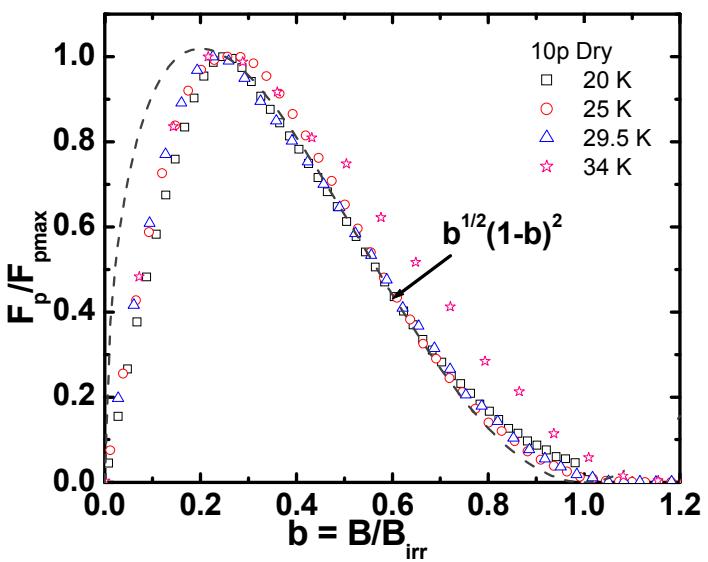
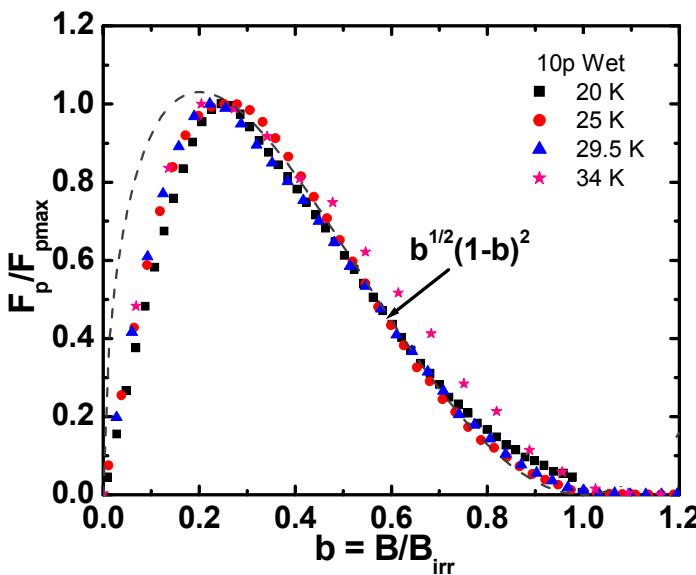
آزمایش:

در این مقاله دو نمونه آلاییده شده به ۱۰٪ سوکسینیک اسید با روش in-situ ساخته شد. در نمونه اول ابتدا بور و سوکسینیک اسید با هم مخلوط و در دمای $20^\circ C$ کلوخه‌سازی شدند تا سوکسینیک اسید تجزیه شود. پودر بدست آمده خشک و با منیزیم مخلوط و به صورت یک قرص فشرده در دمای $900^\circ C$ به مدت ۳۰ دقیقه کلوخه سازی شد (نمونه خشک). در نمونه دوم علاوه بر بور و سوکسینیک اسید تولوئن نیز برای همگن کردن نمونه در مرحله اول استفاده شد (نمونه تر). برای توصیف دقیق تر ساخت نمونه به مرجع [۱۰] رجوع شود. اندازه گیری و تراپریدی های مغناطیسی با استفاده از سیستم اندازه گیری خواص مغناطیسی (PPMS) در دانشگاه ولانگوگ استرلیا توسط یکی از همکاران انجام گرفت.

نتایج و تحلیل داده‌ها:

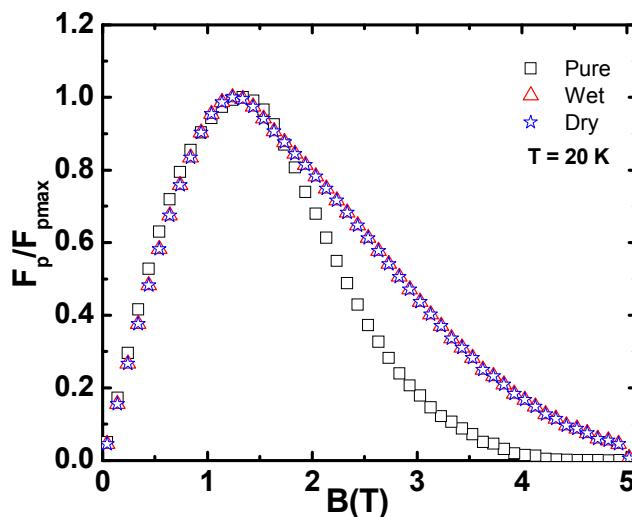
شکل ۱ الگوهای پراش X را برای MgB_2 خالص و نمونه‌های خشک و تر آلاییده به ۱۰٪ وزنی سوکسینیک اسید نشان می‌دهد. همان طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود نمونه‌ها دارای ساختار MgB_2 هستند اما در تمام نمونه‌ها تعداد اندکی قله مربوط به MgO نیز مشاهده می‌شود. MgO فاز غیرابرساناست و می‌تواند به عنوان مرکز میخکوبی عمل کند ولی با کاهش حجم ابررسانایی باعث کاهش دمای بحرانی می‌شود. دمای بحرانی تعیین شده از روی داده‌های مقاومت الکتریکی برای MgB_2 خالص و نمونه‌های خشک و تر آلاییده به سوکسینیک اسید [۱۱]، به ترتیب $37/62$ ، $37/15$ و $36/76$ کلوین می‌باشد. کاهش بیشتر در T_c نمونه خشک می‌تواند به علت مقدار بیشتر MgO در آن باشد.

پارامترهای شیکه از روی داده‌های اشعه X محاسبه شدند. مقادیر به دست آمده برای پارامتر a در نمونه خالص برابر $3/08 \text{ \AA}$ می‌باشد حال آنکه در نمونه‌های آلاییده خشک و تر مقدار آن به ترتیب به $3/071 \text{ \AA}$ و $3/057 \text{ \AA}$ می‌یابد. کاهش در پارامتر a شاهدی بر جانشینی کربن به جای بور است. همچنین جابجایی



شکل ۳: منحنی های (b) $f(b)$ بدست آمده برای نمونه خشک (سمت راست) و نمونه تر (سمت چپ). خطچین منطبق برتابع $b^{1/2}(1-b)^2$ است.

همانطور که در شکل ۳ دیده می شود به جز دمای K نتایج به دست آمده برای هر دو نمونه در $0/2 \leq b \leq 0/2$ به خوبی برتابع $b^{1/2}(1-b)^2$ منطبق می شوند. کاهش درجه دوم نیروی میخکوبی $\propto (1-b)^2$ در میدان های بالا و $\sim 0/2$ از b_{peak} از خصوصیات سازوکار میخکوبی برشی خطوط شار مغناطیسی است [۱۳]. در این حالت وقتی نیروی لورنتس گونه بیشتر از تنش شبکه خطوط شار شود گردشарه ها شروع به حرکت می کنند. از طرفی بر طبق مدل کرامرز $1/2 = p = 2 - q$ از خصوصیات سازوکار میخکوبی مغزی با مراکز میخکوبی عادی، سطحی است [۱۵].



شکل ۴: تغییرات نیروی میخکوبی کاهش یافته با میدان مغناطیسی برای نمونه های خالص خشک و تر در دمای $20 K$.

در دمای K و میدان T مقادیر بدست آمده J_c برای نمونه های تر و خشک به ترتیب هشت و چهار برابر مقداری است که در نمونه خالص مشاهده شده است [۱۲]. بزرگی جریان تحت میدان های بالا به علت افزایش مراکز میخکوبی است. J_c در میدان $3T$ و دمای $25K$ برای نمونه تر تقریبا $2 \times 10^3 A/cm^2$ است که دو برابر مقدار آن برای نمونه خشک است. همانطور که در شکل ۲ دیده می شود مقادیر J_c اندازه گیری شده در نمونه تر برای تمام میدان ها و دماها بزرگتر از نمونه خشک است. این نتایج نشان می دهند که افزودن تولوئن باعث جانشینی بهتر کردن و همگنی نمونه می شود که سبب بهبود اتصالات دانه ای و افزایش J_c می گردد.

نیروی میخکوبی گردشاره ها F_p محاسبه شد. رابطه بین نیروی میخکوبی گردشاره ها و چگالی جریان به صورت $F_p = J_c \times B$ می باشد. برای مقایسه رفتار نمونه ها نیروی میخکوبی کاهش یافته (b) $= B/B_{irr}$ (f = F_p/F_{pmax}) به صورت تابعی از میدان کاهش یافته (b = B/B_{irr}) برای هر دو نمونه در محدوده دمایی $20-34 K$ کلوین در شکل ۳ رسم شده است. برای تعیین میدان برگشت ناپذیری (B_{irr}) از معیار $J_c = 100 A/cm^2$ استفاده شد. همانطور که در شکل ۳ دیده می شود قله منحنی های f برای دو نمونه در حدود $0/2$ است. $0/2 \sim b_{peak}$ در کارهای دیگران نیز مشاهده شده است و به نظر می رسد از خصوصیات ذاتی MgB_2 باشد [۱۳، ۱۴]. از رابطه $b^p(1-b)^q$ جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

- [4] J.H. Kim, S.X. Dou, M.S.A. Hossain, X. Xu, J.L. Wang, D.Q. Shi,T. Nakane, H. Kumakura, Supercond. Sci. Technol. 20 (2007) 715.
- [5] J. H. Lim, S. H. Jang, S. M. Hwang, J. H. Choi, J. Joo, W. N. Kang, C. Kim, physica c, 468(2008)1829-1832
- [6] M. D. Sumption, M. Bhatia, M. Rindfleisch, M. Tomsic,S. Soltanian, S. X. Dou, and E. W. Collings, *Appl. Phys. Lett.* 86 092507(2005).
- [7] Y. Ma, X. Zhang, G. Nishijima, K. Watanabe, S. Awaji, andX. Bai, *Appl. Phys. Lett.* 88 072502 (2006).
- [8] S. R. Ghorbani, X. L. Wang, S. X. Dou, Sung-IK Lee, and M. S.A. Hossain, *Phys. Rev. B*78 (2008) 184502.
- [9] M. R. Cimberle, et all.*Supercond. Sci.Tech.* 15 (2001) 43.
- [10] J. H. Kim, S. X. Dou, M. S. A. Hossain, X. Xu, J. L. Wang, D. Q. Shi,T. Nakane and H. Kumakura, Supercond. Sci. Technol. 20 (2007) 715-719.
- [11] قربانی شعبان رضا، دارینی مرتضی، کنفرانس فیزیک ایران ، همدان صفحه ۱۳۸۹، ۲۷۱۲
- [12] X. L. Wang, Z. X. Cheng, and S. X. Dou, *Appl. Phys. Lett.* **90**,042501 (2007).
- [13] E. Martínez, P. Mikheenko, M. Martínez-López, A. Millán, A. Bevan, and J. S. Abell, *Phys. Rev. B*75 (2007) 134515.
- [14] S. Keshavarzi, M. J. Qin, S. Soltanian, H. K. Liu, and S. X. Dou,*Physica C* 408-410, 601(2004).
- [15] E. J. Kramer, *J. Appl. Phys.* 44 (1973) 1360.
- [16] C. Tarantini, H.U. Aebersold, C. Bernini, V. Braccini, C. Ferdeghini,U. Gambardella, E. Lehmann, P. Manfrinetti, A. Palenzona, I. Pallecchi,M. Vignolo, M. Putti, *Physica C* 463 (2007) 211.

در شکل ۴ مقادیر نیروی میخکوبی در دمای ۲۰ کلوین برای نمونه های خالص ، تر و خشک مقایسه شده است. همانطوری که در شکل ۴ دیده می شود برای میدان های بزرگتر از T_c نیروی میخکوبی توسط آلایش سوکسینیک اسید افزایش می یابد به طوری که نیروی میخکوبی نمونه خالص در T_c صفر شده است در حالی که برای نمونه های آلاییده به سوکسینیک اسید نیروی میخکوبی تا میدان T_c ۵ مخالف صفر است، به عبارتی منحنی ها برای نمونه های آلاییده به سوکسینیک اسید نسبت به نمونه خالص پهن تر شده اند که این پهن شدگی منحنی به علت افزایش نیروی میخکوبی و نهایتاً چگالی جریان بحرانی می باشد.

عمدتا سه سازو کار میخکوبی وجود دارد : میخکوبی مرز دانه، میخکوبی ناکاملی نقطه ای و تغییر پارامتر نظم. میخکوبی ناکاملی نقطه ای باعث پهن شدگی نمودار میخکوبی می شود و تغییر پارامتر نظم با جابجایی قله نمودار نیروی میخکوبی همراه است[۱۶]. همانطور که در شکل ۴ دیده می شود در نمودار قله جابجا نمی شود و چون چگالی مرز دانه برای تمام نمونه ها تقریباً یکسان است پس میتوان نتیجه گرفت که میخکوبی ناشی از ناکاملی نقطه ای است.

نتیجه گیری

با افزودن ۱۰٪ وزنی سوکسینیک اسید به ابررسانای MgB_2 نیروی میخکوبی (F_p) و به تبع آن چگالی جریان بحرانی (J_c) در میدان های مغناطیسی بالا افزایش یافت که دلیل آن جانشینی بخشی از کربن به جای بور ونشستن بخش غیر واکنشی در مرز دانه ها و افزایش میخکوبی شار مغناطیسی می باشد.

سپاسگزاری

از آقایان پروفسور شی و پروفسور ونگ برای همکاری و اجازه هی استفاده از تجهیزات دانشگاه ولونگونگ استرالیا صمیمانه تشکر می گردد.

منابع

- [1] J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani and J. Akimitsu, *Nature* 410 (2001) 63.
- [2] H. L. Suo, C. Beneduce, M. Dhalle, N. Musolino, J-H. Genoud, and R. Flükiger, *Appl. Phys. Lett.* 79 (2001) 3116-3118.
- [3] W.J. Feng, T.D. Xia, T.Z. Liu,W.J. Zhao, Z.Q.Wei, *Physica C* 425 (2005)144.